## 2 段階 Cs<sub>0.2</sub>FA<sub>0.8</sub>PbI<sub>x</sub>Br<sub>3-x</sub>ペロブスカイトの I/Br 組成比に対する誘電関数スペクトル Dielectric function of Cs<sub>0.2</sub>FA<sub>0.8</sub>PbI<sub>x</sub>Br<sub>3-x</sub> perovskite from two-step reaction

埼玉大理工研 三浦拓也、石川良、上野啓司、白井肇

Graduate School of Sci. & Eng., Saitama U., T. Miura, R. Ishikawa, K. Ueno, and H. Shirai **1. はじめに**: これまで Cs<sub>0.2</sub>FA<sub>0.8</sub>PbI<sub>x</sub>Br<sub>3-x</sub> ペロブスカイトは MA 系に比較して大気安定性、耐 熱性に優れ、且つ I/Br 組成比によりバンドギャップ制御が可能であることが報告されている。我々 は CsI+PbI<sub>2</sub>系 CsPbI<sub>2</sub> 膜に FAI/FABr 混合比 *x* を変数として FAI<sub>x</sub>Br<sub>1-x</sub>/IPA 滴下による2段階反応 で Cs<sub>0.2</sub>FA<sub>0.8</sub>PbI<sub>x</sub>Br<sub>3-x</sub> 薄膜を作製し光電物性を検討してきた。今回は Cs<sub>0.2</sub>FA<sub>0.8</sub>PbI<sub>x</sub>Br<sub>3-x</sub> ペロ ブスカイトの誘電関数の *x* に対する光学遷移と微細構造を考察した結果を報告する。

2. 実験: CsI+PbI<sub>2</sub>とDMF/TBP 溶液からスピンコート(SC)で前駆体 CsPbI<sub>2</sub>を形成し、その後xを 変数として FAI<sub>x</sub>Br<sub>1-x</sub>/IPA 溶液を滴下した後 50 秒後に SC、100℃、5 分熱処理することで Cs<sub>0.2</sub>FA<sub>0.8</sub>PbI<sub>x</sub>Br<sub>3-x</sub>を作製した。膜の評価は、XRD、PL、UV/vis、XPS、分光エリプソメトリー(SE)、 顕微鏡観察、定常光電流、定常光グレーティング(SSPG)により行った。誘電関数の解析は、 Modified amorphous model による3 層モデルを用い、有効媒質近似(EMA)を用いた。

3. 結果と考察:図1は Cs<sub>0.2</sub>FA<sub>0.8</sub>PbI<sub>x</sub>Br<sub>3-x</sub>の x に対する XRD、PL を示す。xに対して系統的に =14.2<sup>°</sup>の(110)に起因するピークは高角側へシフトし、且つ PL ピークエネルギーは高エネルギー 側へシフトした。また表面ラフネスは Br 比の増大とともに減少した。図2は SE 解析から決定した  $E_{I}$ ,  $E_{2}$ ,  $E_{3}$ ,  $E_{5}$  成分の光学遷移のxに対する変化を示す。 $E_{I}$ ,  $E_{2}$ ,  $E_{3}$  成分については、FAI100%から FABr 量の増大とともに  $\epsilon_{2}$ の大きさは FAI:FABr=50:50 のペロブスカイトで最小となり、その後高エ ネルギー側へのシフトを伴って増大した。一方  $E_{5}$ 成分は FABr 比の増大とともに減少し、且つ高エ ネルギー側へシフトした。またベストフィットした光学モデルから FAI:FABr=50:50 の膜で屈折率が 最小で膜中のボイド体積分率は最大となった。以上の結果は、FAI:FABr=50:50 前後では最も粗 な構造であり、 $\epsilon_{2}(E)$ のxに対する変化は FAI:FABr=50:50 付近で不連続であることを示唆する。 4. まとめ:2段階法で作製した Cs<sub>0.2</sub>FA<sub>0.8</sub>PbI<sub>x</sub>Br<sub>3-x</sub>のx に対する微細構造は FAI:FABr=50:50 付



図1(上)XRD, (下)PLのxに対する変化

図2 E1, E2, E3, E5の光学遷移のxに対する変化